FOR USE BY ELECTRICIANS OVERSEAS:

最新トランジスタ規格表 (New Transistor Manual) lists all the transistors registered with the Electronic Industries Association of Japan (EIAJ), arranged in a manner easy to look up. We hope that you will make full use of the data provided in this manual by referring to the Japanese-English translation key given below.

型 名	社 名	用 途	構 造	最大定格（$T_a=25$°C）					電気的特性（$T_a=25$°C）														外形	備 考
				V_{CBO}	V_{EBO}	I_C	P_C	T_j	I_{CBO}最大値		直流又はパルスh_{FE}			バイアス		h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}*	h_{re} h_{rb}*	h_{oe} h_{ob}*	f_{ab} f_T*	C_{ob}	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)*		
				(V)	(V)	(mA)	(mW)	(°C)	(μA)	V_{CB}(V)		V_{CE}(V)	I_C(mA)	V_{CB}(V)	I_E(mA)		(Ω)	$(\times10^{-4})$	(μ℧)	(Mc)	(pF)	Ω)		
1	2	3	4	5					6		7			8						9	10		11	12

1 TYPE NUMBER

2 ORIGINAL MANUFACTURER

3 USES

4 MATERIAL AND STRUCTURE

5 MAXIMUM RATINGS

6 I_{CBO} MAXIMUM VALUE AND V_{CB} VALUE (CRITERIA FOR MEASURING I_{CBO})

7 STANDARD VALUE OF DC/PULSE h_{FE} AND V_{CE}, I_C (CRITERIA FOR MEASURING DC/PULSE h_{FE})

8 STANDARD VALUE OF h PARAMETERS AND BIAS V_{CB}, I_E (CRITERIA FOR MEASURING h PARAMETERS)

* INDICATES VALUE IN GROUNDED-BASE OPERATION, OTHERWISE VALUE IN EMITTER-GROUNDED OPERATION.

9 f_{ab} OF RF CHARACTERISTIC, EXCEPT IN CASE OF * WHICH INDICATES VALUE OF f_T.

10 C_{ob} AND $r_{bb'}$ OF RF CHARACTERISTICS EXCEPT IN CASE OF * IN $r_{bb'}$ COLUMN WHICH INDICATES VALUE OF h_{ie} (real)

11 OUTLINE

12 REMARKS

：とコンプリ： COMPLEMENTARY TO ………

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C)					電気的特性 (T_a = 25°C)														外形	備考
				V_{CBO}	V_{EBO}	I_C	P_C	T_j	I_{CBO} 最大値		直流又はパルス h_{FE}			バイアス		h_{fe}	h_{ie} h_{ib}*	h_{re} h_{rb}*	h_{oe} h_{ob}*	$f_{\alpha b}$ f_T*	C_{ob}	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)*		
				(V)	(V)	(mA)	(mW)	(°C)	(μA)	V_{CB}(V)		V_{CE}(V)	I_C(mA)	V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fb}*	(Ω)	$(\times 10^{-4})$	(μ℧)	(Mc)	(pF)	(Ω)		
2SC1781	日立	RF	Si. E	70	5	500	350	175	0.5	50	80～240	3	10	3	−10	t_{on}=35nS, t_{off}=350nS t_{stg}=300nS				150 *	6	350 *	49C	
〃 1782	サンケン	PA	Si.TMe	140	6	10 A	100W (T_c=25°C)	150	100	140	60	4	3 A	12	−500					10 *	165	13 *	102	
〃 1783	〃	〃	〃	180	6	10 A	100W (T_c=25°C)	150	100	180	60	4	3 A	12	−500					10 *	165	13 *	102	
〃 1784	〃	〃	〃	150	6	15 A	100W (T_c=25°C)	150	100	150	20	4	5 A			t_r<1.5μS t_f<1μS t_{stg}<4μS							102	
〃 1785	〃	〃	〃	200	6	15 A	100W (T_c=25°C)	150	100	200	20	4	5 A			t_r<1.5μS t_f<1μS t_{stg}<4μS							102	
〃 1786	〃	〃	〃	230	6	15 A	100W (T_c=25°C)	150	100	230	20	4	5 A			t_r<1.5μS t_f<1μS t_{stg}<4μS							102	
〃 1787	松下	RF. LN	Si. EP	35	5	30	150	125	0.1	10	540	5	2	10	− 1	NF= 6 dB (100Hz, 10V, 200μA)				150 *	2.2	70	276	2SA880 とコンプリ
〃 1788	〃	PA	〃	25	7	500	600	135	10	25	160	2	500	10	−50					150 *	6	3.5k	138	2SA1128 とコンプリ
〃 1789	〃	RF. Mix. Conv. Osc	〃	25	3	50	200	125	0.1	25	100	10	2	10	−10					1200*	1.05	20	138	
〃 1790	〃	RF	〃	25	3	15	150	175	100	25	50	10	2	10	− 3					3000*	1.2	20	50C	
〃 1791	日電	PA	Si. E	45	4	1 A	11W (T_c=25°C)	200	500	30	60	10	500	10	−300	P_o= 6 W (f=1GHz, V_{CC}=18V, P_i=2W)				1200*	C_{re} < 7		184	
〃 1792	〃	〃	〃	45	4	2 A	22W (T_c=25°C)	200	1mA	18	60	10	500	10	−600	P_o=10W (f=1GHz, V_{CC}=18V, P_i=4W)				800 *	C_{re} <14		184	
〃 1793																								
〃 1794																								
〃 1795																								
〃 1796																								
〃 1797	日電	PA	Si. E	50	3.5	300	6 W (T_c=25°C)	200	200	28	60	10	100			P_o=1.6W, η=33% (f=2GHz, V_{CC}=28V, P_i=0.5W)					C_{re} < 3		118	
〃 1798	〃	〃	〃	50	3.5	1 A	11.6W (T_c=25°C)	200	500	28	60	10	150			P_o=3.1W, η=35% (f=2GHz, V_{CC}=28V, P_i=0.5W)					C_{re} < 6		118	
〃 1799	〃	〃	〃	50	3.5	2 A	19.5W (T_c=25°C)	200	500	28	60	10	200			P_o=6.3W, η=33% (f=2GHz, V_{CC}=28V, P_i= 1 W)					C_{re} < 9		118	
〃 1800	〃	〃	〃	50	3.5	3 A	29W (T_c=25°C)	200	500	28	60	10	500			P_o>10W, η=35% (f=2GHz, V_{CC}=28V, P_i=3.2W)					C_{re} <10		118	
〃 1801	新日無	RF	Si. EP	30	3	30	150	125	0.5	15	60	10	5	10	−10					1300*	1	$C_c r_{bb'}$ 6 pS	138D	
〃 1802	〃	〃	〃	30	3	20	150	125	0.5	15	60	6	2	10	− 2					700 *	1	$C_c r_{bb'}$ 2.5pS	138D	
〃 1803	日電	RF. LN	Si. E	30	3	130	580	200	0.1	20	100	5	50	5	−50					2700*	C_{re} 1	15 *	306	
〃 1804	三菱	PA	Si. EP	47	4	1 A	10W (T_c=25°C)	175	200	30	50	25	100			P_o=4.5W (f=770MHz, V_{CC}=25V, P_i= 1 W)							273	
〃 1805	〃	〃	〃	45	4	2 A	30W (T_c=25°C)	175	1mA	35	50	25	100			P_o=12W (f=770MHz, V_{CC}=25V, P_i=3.5W)							273	
★ 〃 1806	〃	〃	〃	45	4	4 A	50W (T_c=25°C)	175	2mA	35	50	25	200			P_o=26W (f=770MHz, V_{CC}=25V, P_i= 8 W)							273	
★ 〃 1807	〃	RF. PA	〃	18	4	0.1A	300	175	30	10	10～180	7.2	20			P_o=25mW (f=485MHz, V_{CC}=7.2V, P_{in}=5mW)								
〃 1808	〃	〃	〃	35	3.5	1 A	10W (T_c=25°C)	175	100	15	10～180	10	0.1A			P_o=3.5W (f=485MHz, V_{CC}=13.5V, P_{in}=0.4W)							312	
〃 1809	東洋電具	RF. Mix Osc. Conv	〃	25	4	20	150	125	0.5	20	39～180	6	1	6	− 1					500 *	1.4		138	
〃 1810	ソニー	PA	Si. T	700	12	300	950	120	2	12	50	5	10	10	−10					13 *	8.5	$C_c r_{bb}$ 170pS	174B	